2SC1167

シリコンNPN三重拡散メサ形トランジスタ
SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR

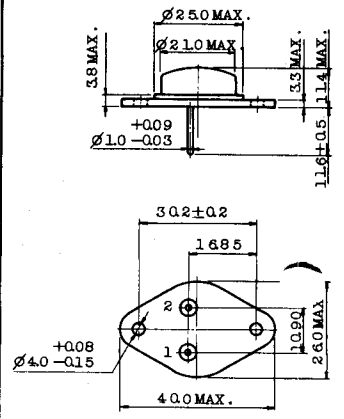
TENTATIVE

○ 白黒テレビ水平偏向出力用

∘ Black and White TV Horizontal Output Applications

- 超高耐圧です； $V_{CBO}=1200V$
- 飽和電圧が低い； $V_{CE(sat)}=8V$(Max.)
- スイッチング時間が速い； $t_f=0.5\mu s$(Typ.)

Unit in mm



1. BASE
2. EMITTER
COLLECTOR (CASE)

JEDEC	TO−3
EIAJ	TO−3, TB−3
TOSHIBA	2−21B1A

アクセサリはAC42Cを適用
MOUNTING KIT No.AC42C

最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	1200	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CES}	1200	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	1.5	A
エミッタ電流	I_E	−1.5	A
コレクタ損失(Tc=25℃)	P_C	50	W
接合温度	T_j	150	℃
保存温度	T_{stg}	−65～150	℃

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25 ℃)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしや断電流	I_{CBO}	V_{CB} = 500V I_E = 0	–	–	10	μA
エミッタしや断電流	I_{EBO}	V_{EB} = 5V I_C = 0	–	–	1	mA
直流電流増幅率	h_{FE}	V_{CE} = 10V I_C = 0.5A	10	–	–	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	V_{CE}(sat)	I_C = 1.0A I_B = 0.4A	–	–	8.0	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	V_{BE}(sat)	I_C = 1.0A I_B = 0.4A	–	–	1.5	V
トランジション周波数	f_T	V_{CE} = 10 V I_C = 0.1 A	-	3	–	MHz
下降時間 (Fig 1)	t_f	I_{CP} = 1.0A $I_{B1(end)}$ = 0.4 A	–	0.5	1.0	μs
コレクタ出力容量	C_{ob}	V_{CB} = 10V I_E=0, f=1MHz	–	45	–	pF

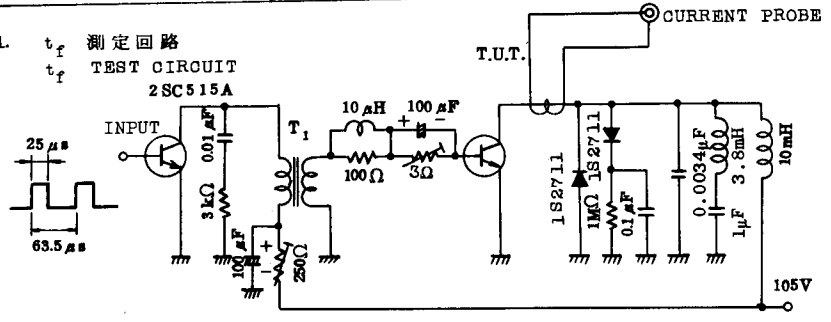
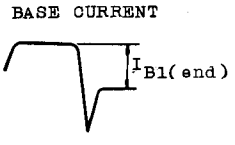
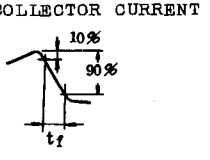



Fig 1. t_f 測定回路
t_f TEST CIRCUIT